

第五章 存储系统和结构





- 5.1 存储系统的组成
- 5.2 主存储器的组织
- 5.3 半导体随机存储器和只读存储器
- 5.4 主存储器的连接与控制
- 5.5 提高主存读写速度的技术
- 5.6 多体交叉存储技术
- 5.7 高速缓冲存储器
- 5.8 虚拟存储器



- 5.1 存储系统的组成
- 5.2 主存储器的组织
- 5.3 半导体随机存储器和只读存储器
- 5.4 主存储器的连接与控制
- 5.5 提高主存读写速度的技术
- 5.6 多体交叉存储技术
- 5.7 高速缓冲存储器
- 5.8 虚拟存储器





要组成一个主存,首先要考虑选片的问题,然后就是如何把芯片 连接起来的问题。根据存储器所要求的容量和选定的存储芯片的 容量,就可以计算出总的芯片数,即

- 例如:存储器容量为8K×8,若选用1K×4的存储芯片,则需要:

总片数=
$$\frac{8K\times8}{1K\times4}$$
 = 8×2 片= 16片

- 将多片组合起来常采用位扩展法、字扩展法、字和位同时扩展法。







1.位扩展

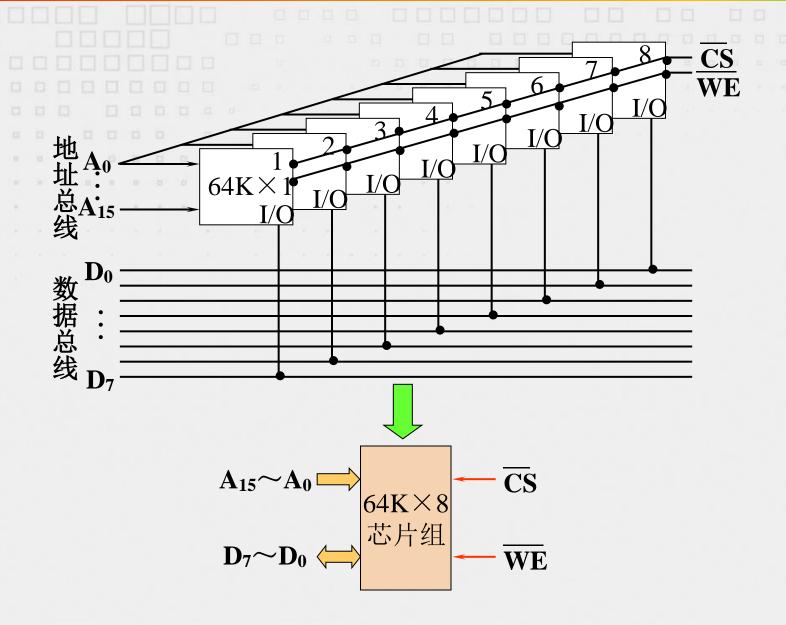
- 位扩展指只在位数方向扩展(加大字长),而芯片的字数和存储器的字数是一致的。
- 如用64K×1的SRAM芯片组成64K×8的存储器,需要8个芯片。

	容量	地址	数据
存储器	64K×8	16	8
存储芯片	$64K\times1$	16	1





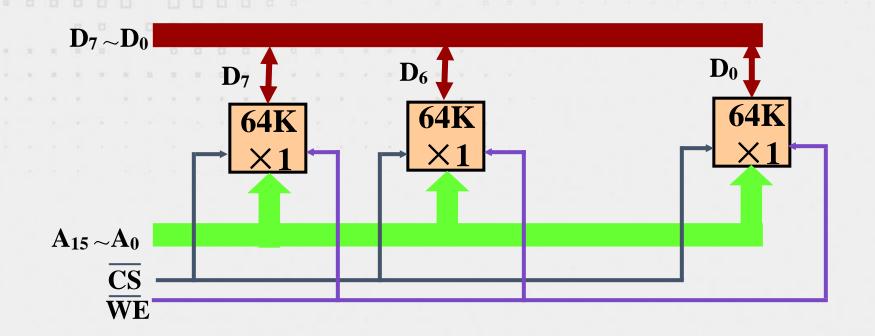


















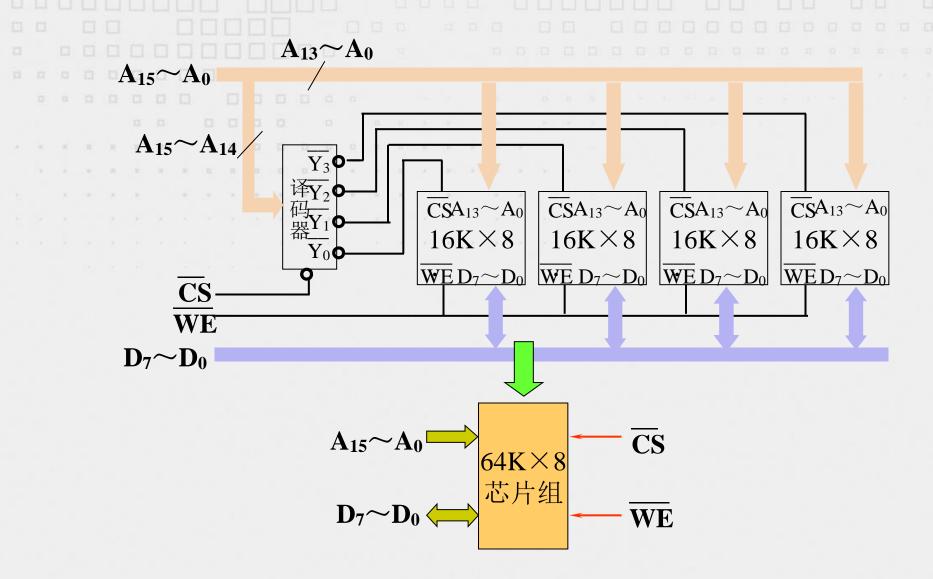
- 2.字扩展
 - 字扩展是指仅在字数方向扩展,而位数不变。
 - 如用16K×8的SRAM组成64K×8的存储器,需要4个芯片。

	容量	地址	数据
存储器	64K×8	16	8
存储芯片	16K×8	14	8



5.4.1

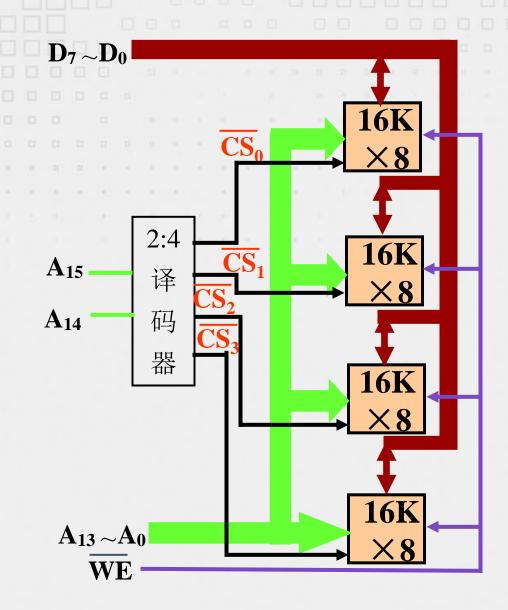


















- 在同一时间内四个芯片中只能有一个芯片被选中。四个芯片的地址分配如下:
- 第一片
 - 最低地址 0000H
 - 最高地址 3FFFH

- 第二片
 - 最低地址 4000H
 - 最高地址 7FFFH
- 第三片
 - 最低地址 8000H
 - 最高地址 BFFFH
- 第四片
 - 最低地址 C000H
 - 最高地址 FFFFH







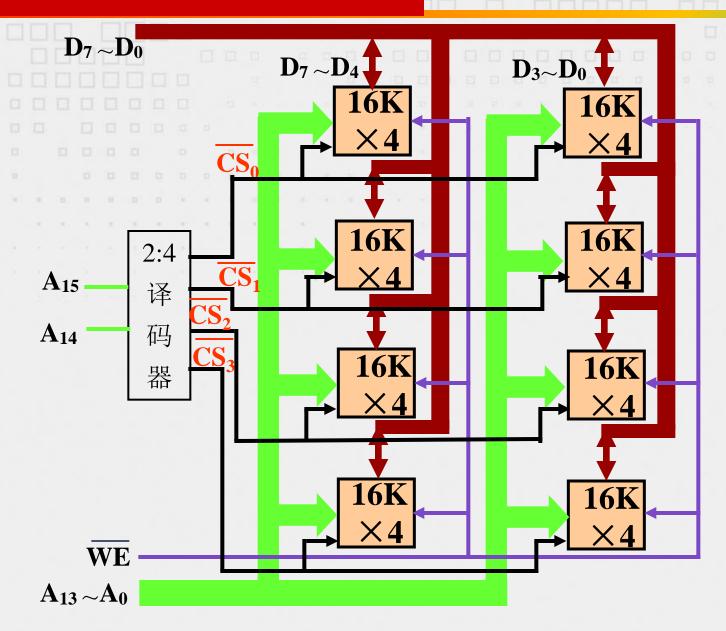
- 3.字和位同时扩展
 - 当构成一个容量较大的存储器时,往往需要在字数方向和位数方向上同时 扩展。
 - 如用16K×4的SRAM组成64K×8的存储器,需要8个芯片。

	容量	地址	数据
存储器	64K×8	16	8
存储芯片	$16K\times4$	14	4



5.4.1











 片内的字选是由CPU送出的N条低位地址线完成的,地址线直接 接到所有存储芯片的地址输入端(N由片内存储容量2^N决定),
 而片选信号则是通过高位地址得到的。







- 实现片选的方法:
 - 线选法
 - 全译码法
 - 部分译码法







- 1.线选法
 - 线选法就是用除片内寻址外的高位地址线直接分别接至各个存储芯片的片选端,当某地址线信息为"0"时,就选中与之对应的存储芯片。







假设4片2K×8的芯片,构成8K×8的存储器。

芯片 0#	A ₁₄ ~ A ₁₁ 1 1 1 0	$A_{10} \sim A_0$ 000	地址范围 7000~
		111	77FFH
1#	1101	000	6800 ~
		111	6FFFH
2#	1011	000	5800 ~
		111	5FFFH
3#	0111	000	3800 ~
		111	3FFFH







- 2.全译码法
 - 全译码法将片内寻址外的全部高位地址线作为地址译码器的输入,把经译码器译码后的输出作为各芯片的片选信号,将它们分别接到存储芯片的片选端,以实现对存储芯片的选择。



5.4.2

存储芯片的地址分配和片选



假设4片2K×8的芯片,构成8K×8的存储器,若CPU地址总线20位。

芯片	$A_{19} \sim A_{13}$	$\mathbf{A}_{12}\mathbf{A}_{11}$	$A_{10} \sim A_0$	地址范围
0#	0 0	0 0	000 111	00000~ 007FFH
1#	0 0	0 1	000 111	00800~ 00FFFH
2#	0 0	1 0	000 111	01000~ 017FFH
3#	0 0	1 1	$000 \\ 111$	01800~ 01FFFH



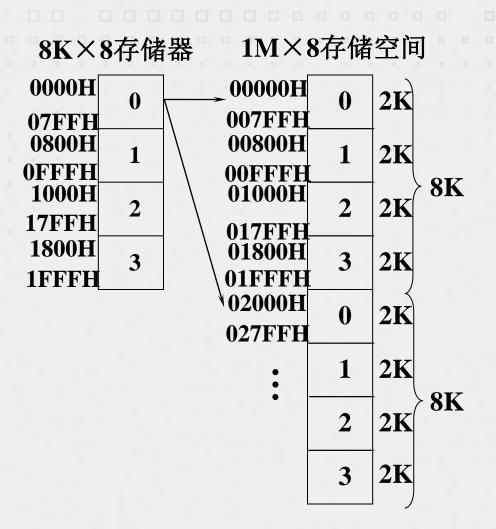


• 3.部分译码

- 所谓部分译码即用片内寻址外的高位地址的一部分来译码产生片选信号。
- 如用4片2K×8的存储芯片组成8K×8存储器,需要四个片选信号,因此只要用两位地址线来译码产生。
- 设地址总线有20位($A_{19} \sim A_0$),则寻址8K×8存储器时,无论 $A_{19} \sim A_{13}$ 取何值,只要 $A_{12} = A_{11} = 0$,而均选中第一片,只要 $A_{12} = 0$,A₁₁ = 1,均 选中第二片,……。
- 也就是说, 8K RAM中的任一个存储单元,都对应有2⁽²⁰⁻¹³⁾ = 2⁷ 个地址, 这种一个存储单元出现多个地址的现象称地址重叠。



从地址分布来看,这8KB存储器实际上占用了CPU全部的空间(1MB)。每片2K×8的存储芯片有1/4M=256K的地址重叠区。





课题习题



- 例1 用2114($1K\times4$)SRAM芯片组成容量为 $4K\times8$ 的存储器。 地址总线 $A_{15}\sim A_0$ (低),双向数据总线 $D_7\sim D_0$ (低),读/写信号线R/W。给出芯片地址分配与片选逻辑,并画出M框图。
 - 1.计算芯片数
 - (1) 先扩展位数,再扩展单元数。
 2片1K×4 → 1K×8 > 8片
 4组1K×8 → 4K×8
 - (2) 先扩展单元数,再扩展位数。



课堂习题



2.地址分配与片选逻辑

存储器寻址逻辑

了芯片内的寻址系统 、芯片内的<mark>地址分配与片选逻辑</mark>

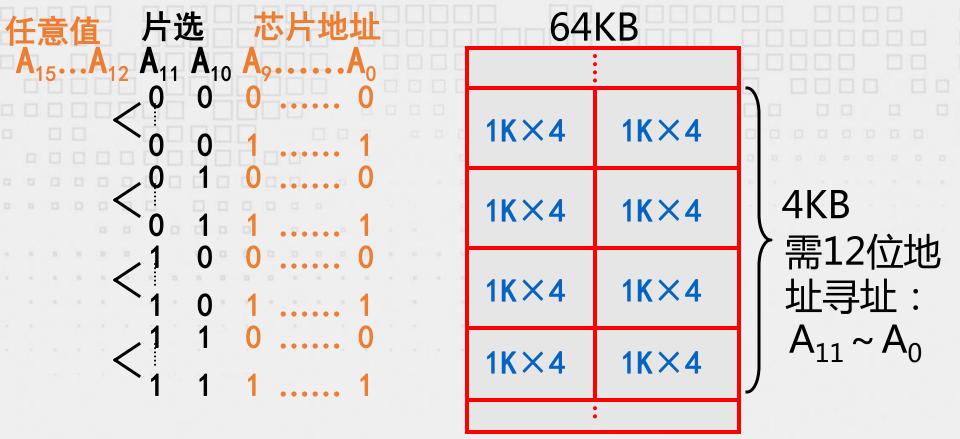
为芯片分配哪几位地址, 以便寻找片内的存储单元

由哪几位地址形成<mark>芯</mark>片选择逻辑,以便寻找芯片

存储空间分配:

4KB存储器在16位地址空间(64KB)中占据任意连续区间。





低位地址分配给芯片,高位地址形成片选逻辑。

芯片	芯片地址	片选信号	片选逻辑	
1K	$A_9 \sim A_0$	$\overline{CS_{o}}$	$\overline{\mathbf{A}}_{11}\overline{\mathbf{A}}_{10}$	
1K	$A_9 \sim A_0$	CS ₁	$\overline{\mathbf{A}}_{11}\mathbf{A}_{10}$	
1K	$A_9 \sim A_0$	$\overline{\text{CS}_2}$	$\mathbf{A}_{11}\overline{\mathbf{A}_{10}}$	
1K	$A_9 \sim A_0$	$\overline{CS_3}$	$A_{11}A_{10}$	

3.连接方式 (1)扩展位数 (2)扩展单元数 (3)连接控制线 $\begin{array}{c} D_7 \sim D_4 & 4 \\ D_3 \sim D_0 & 4 \end{array}$ 1K×4 1K×4**←** 1K×4**←** 1K×4 R/W_ $1K\times4$ $1K\times4$ $1K\times4$ $1K\times4$ A9~A0 10 CS₀ 10 **10** 10 $\overline{\text{CS}_1}$ CS₃ CS₂ $\mathbf{A_{11}} \quad \mathbf{A_{10}}$ \mathbf{A}_{11} \mathbf{A}_{10} $\mathbf{A}_{11} \ \mathbf{A}_{10}$ \mathbf{A}_{11} \mathbf{A}_{10}

(4)形成片选逻辑电路

课堂习题



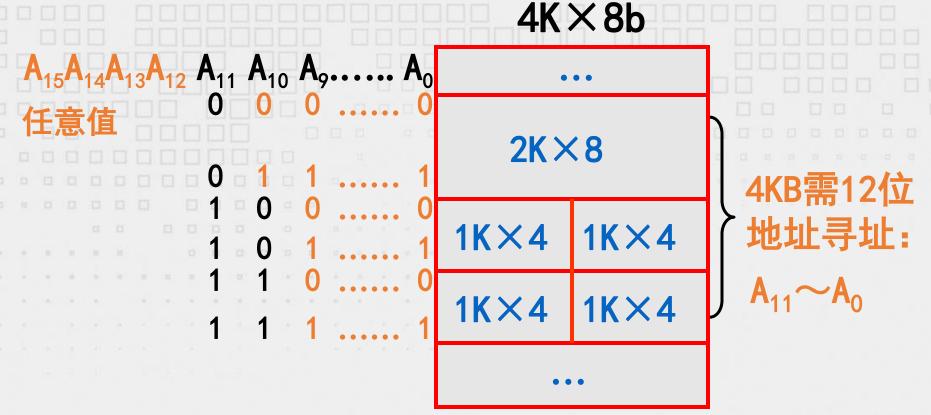
- 例2 某半导体存储器容量4K×8b。其中固化区2KB选用EPROM 芯片2716(2K×8b);工作区2KB,选用RAM芯片2114(1K×4b)。
 地址总线A₁₅~A₀(低),双向数据总线D₇~D₀(低),读/写信号线R/W。
 - 1.计算芯片数
 - x (1) 先扩展位数,再扩展单元数。

ROM区: 2KB RAM区: 2KB

x (2) 先扩展单元数,再扩展位数。

存储空间分配: 先安排大容量芯片(放地址低端),便于拟定片选逻辑。 再安排小容量芯片。

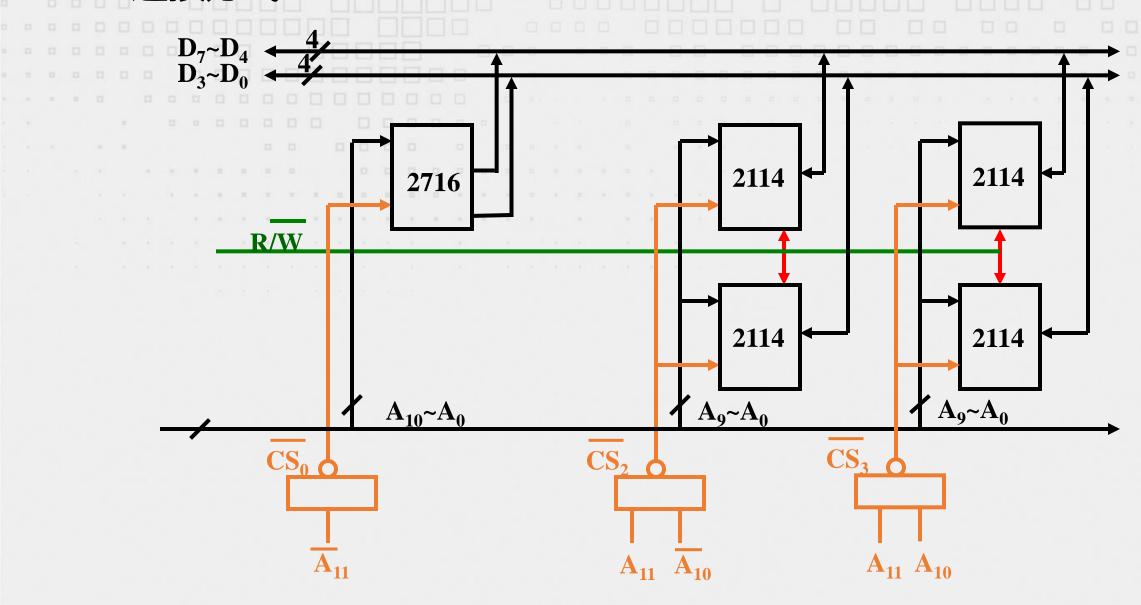




低位地址分配给芯片,高位地址形成片选逻辑。

芯片	芯片地址	片选信号	片选逻辑	
2K	$A_{10} \sim A_0$	<u>CS</u> ₀	A ₁₁	
1K	$A_9 \sim A_0$	$\overline{\text{CS}_1}$	$\mathbf{A}_{11}\mathbf{\overline{A}}_{10}$	
1K	$A_9 \sim A_0$	$\overline{\mathtt{CS}_2}$	$A_{11}A_{10}$	

3.连接方式



课堂习题



设计一个容量为16KB(按字节编址)的存储器,从低地址向高地 址依次为4KB固化区(选用2KB/片的EPROM芯片)、4KB的空区(无存 储芯片)、8KB的随机读/写区(选用4K×4位的RAM芯片)。CPU的地 址总线为 $A_{15} \sim A_0$ (低),双向数据总线为 $D_7 \sim D_0$ (低),读/写控制信 号为R/W, 访存请求信号为MREQ。请设计出该存储器, 并与CPU 连接。



课堂习题

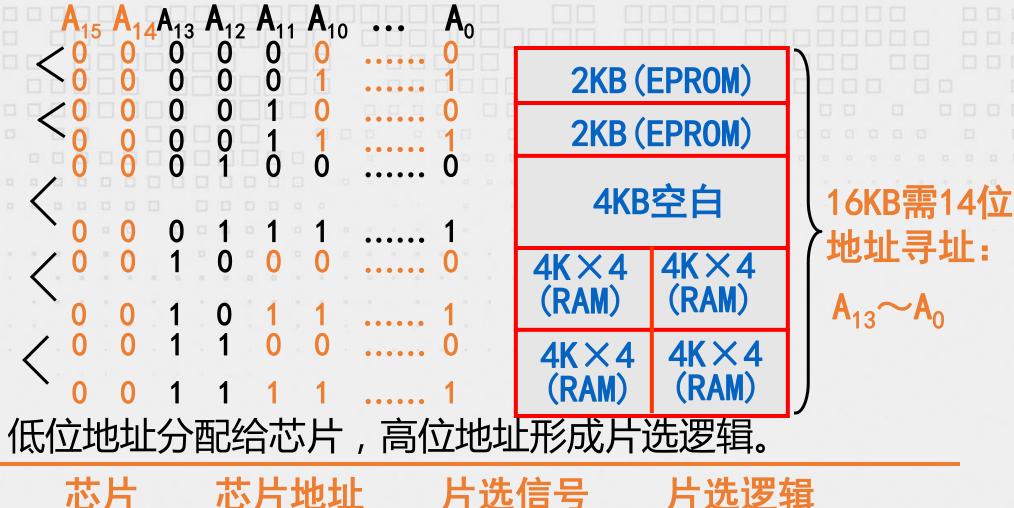


1. 芯片的选择

固化区:4KB (2片) 随机读/写区:8KB (4片) 共6片

2.地址分配与片选逻辑





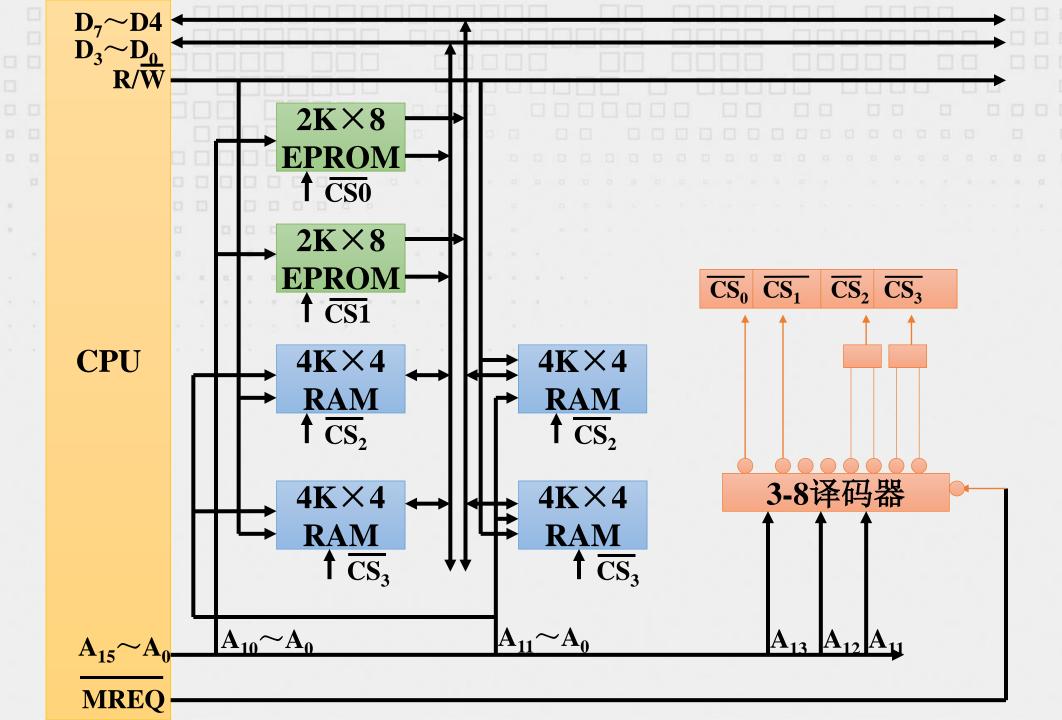
 芯片
 芯片地址
 片选信号
 片选逻辑

 2K
 $A_{10} \sim A_0$ $\overline{CS_0}$ $\overline{A_{13}} \overline{A_{12}} \overline{A_{11}}$

 2K
 $A_{10} \sim A_0$ $\overline{CS_1}$ $\overline{A_{13}} \overline{A_{12}} \overline{A_{11}}$

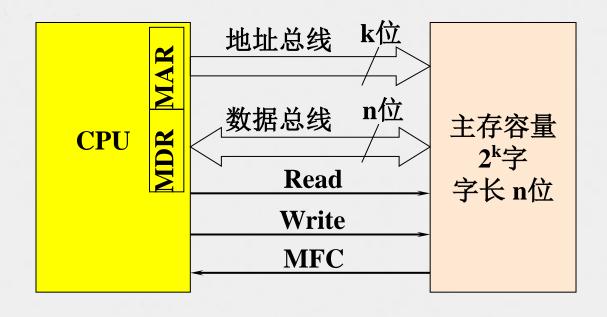
 4K
 $A_{11} \sim A_0$ $\overline{CS_2}$ $A_{13} \overline{A_{12}}$

 4K
 $A_{11} \sim A_0$ $\overline{CS_3}$ $A_{13} \overline{A_{12}}$





- 1.主存和CPU之间的硬连接
 - 主存与CPU的硬连接有三组连线:地址总线(AB)、数据总线(DB)和控制总线(CB)。









- 2.CPU对主存的基本操作
 - CPU与主存的硬连接是两个部件之间联系的物理基础,而两个部件之间还有软连接,即CPU向主存发出的读或写命令,这才是两个部件之间有效工作的关键。





- (1)读
 - 读操作是指从CPU送来的地址所指定的存储单元中取出信息,再送给CPU
 - , 其操作过程是:
 - 地址→MAR→AB CPU将地址信号送至地址总线
 - ReadCPU发读命令
 - Wait for MFC 等待存储器工作完成信号
 - ((MAR))→DB→MDR 读出信息经数据总线送至CPU





- (2)写
 - 写操作是指将要写入的信息存入CPU所指定的存储单元中,操作过程是:

- 地址→MAR→AB CPU将地址信号送至地址总线

- 数据→MDR→DB CPU将要写入的数据送至数据总线

- Write CPU发写命令

- Wait for MFC 等待存储器工作完成信号







数据总线一次能并行传送的位数,称为总线的数据通路宽度,常见的有8位、16位、32位、64位几种。但大多数主存储器常采取字节编址,每次访存允许读/写8位,以适应对字符类信息的处理。

- 1.8位存储器接口
 - 如果数据总线为8位(如微机系统中的PC总线),而主存按字节编址,则匹配关系比较简单。一个总线周期中读/写8位







- 2.16位存储器接口
 - 对于16位的微处理器8086(或80286),在一个总线周期内可读/写两个字节,即先送出偶地址,然后同时读/写这个偶地址单元和随后的奇地址单元,用低8位数据总线传送偶地址单元的数据,用高8位数据总线传送奇地址单元的数据,这样读/写的字(16位)被称为规则字。





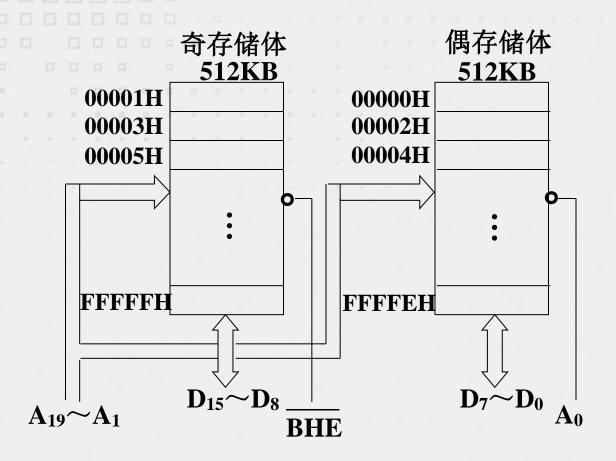


- 如果读/写的是非规则字,即是从奇地址开始的字,这时需要安排两个总线周期才能实现。
- 8086微处理器的地址线 $A_{19} \sim A_1$ 同时送至两个存储体, \overline{BHE} (高位存储体)和最低位地址线 A_0 用来选择一个或两个存储体进行数据传送。















• 8086微处理器的地址线 $A_{19} \sim A_1$ 同时送至两个存储体,BHE(高位存储体)和最低位地址线 A_0 用来选择一个或两个存储体进行数据传送。

BHE	A_0	特征
0	0	全字(规则字)传送
0	1	在数据总线高8位上进行字节传送
1	0	在数据总线低8位上进行字节传送
1	1	备用。





- 5.1 存储系统的组成
- 5.2 主存储器的组织
- 5.3 半导体随机存储器和只读存储器
- 5.4 主存储器的连接与控制
- 5.5 提高主存读写速度的技术
- 5.6 多体交叉存储技术
- 5.7 高速缓冲存储器
- 5.8 虚拟存储器



并行访问存储器



常规的主存是单体单字存储器,只包含一个存储体。在高速的计算机中,普遍采用并行主存系统,即在一个存取周期内可以并行读出多个字,依靠整体信息吞吐率的提高,以解决CPU与主存之间的速度匹配问题。





并行访问存储器



- 多个并行工作的存储器共有一套地址寄存器和译码电路,按同一 地址并行地访问各自的对应单元。
- 并行访问存储器按地址在一个存取周期内可读出n×w位的指令或数据,使主存带宽提高n倍。





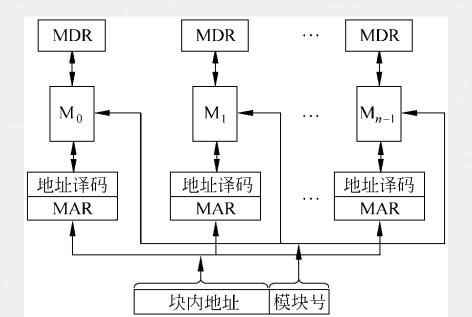
交叉访问存储器



• 交叉访问存储器中有多个容量相同的存储模块(存储体),而且

各存储模块具有各自独立的地址寄存器、读写电路和数据寄存器

,这就是多体系统。各个存储体能并行工作,又能交叉工作。





课堂习题



- 1.有一个16K×16位的存储器,由1K×4位的DRAM芯片构成(芯片是64×64结构)。问:
 - (1)共需要多少RAM芯片。
 - (2)存储体的组成框图。
- 2.某半导体存储器容量 $7K \times 8b$ 。其中固化区 $4K \times 8b$ 可选EPROM芯片: $2K \times 8b$ /片;随机读写区 $3K \times 8b$,可选SRAM芯片 $2K \times 4b$ /片、 $1K \times 4b$ /片。地址总线 $A_{15} \sim A_0$ (低),双向数据总线 $D_7 \sim D_0$ (低),R/W控制读/写。另有控制信号MREQ,低电平是允许存储器工作
 - 。设计并画出存储器逻辑图。

THANK YOU

